

## ANEXO 1

### Tarifas de Procesos por encomienda actualizadas a Jun. 2017

ETAPA	DESCRIPCION	C - Run	C - Oblea	C - Paso	Obleas Paso
AAFM-ING	Caracterització per AFM	15,80	0,00	0,00	4,00
AEBL-ING	Litografia per EBL a l'equip RAITH150TWO	26,59	0,00	0,00	4,00
AFIB-ING	Nanoestructuració al FIB (talls, seccions, lamel·les, edició circuits...)	35,48	0,00	0,00	4,00
ALDD-ALM	Atomic layer deposition of dielectrics - Standard deposition of aluminum oxide	8,78	0,00	5,00	2,00
ALDD-HAF	Atomic layer deposition of dielectrics - Standard deposition of hafnium oxide	8,78	0,00	5,00	2,00
ALDD-ING	Dipòsit de capes dielèctriques per Atomic Layer Deposition (ALD)	8,78	0,00	5,00	1,00
AMRIEING	Gravat RIE no estàndar a l'AMI-ETCH	32,40	0,33	0,00	0,00
ANIL-ING	Nano-impressió amb el NIL d'Obducat de 4	13,86	0,00	0,00	4,00
ASEM-ING	Inspecció SEM a l'equip LEO1530	14,83	0,00	0,00	4,00
CMOS-MNC	Transferència de les mostres a porta-mostres MNC	0,00	0,00	0,00	0,00
DAMI-ING	Dipòsit de dielèctrics no estàndar per PECVD a l'AMIDEP	9,00	2,19	0,00	8,00
DAMINTXX	Depósito de nitruro PECVD basado en silano	9,00	1,13	0,00	8,00
DAMIOX11	Depósito de óxido PECVD TEOS1:1	9,00	1,03	0,00	8,00
DAMIOX21	Deposición de óxido PECVD TEOS ratio 2:1	9,00	1,06	0,00	8,00
DAMIOXC1	Deposición de óxido con silano PECVD	9,00	1,05	0,00	8,00
DAMIPASX	Depósito PECVD de óxido TEOS y nitruro para pasivación	9,00	2,19	0,00	8,00
DBPTEOSX	Deposición de óxido dopado PECVD TEOS de grosores variables	9,00	1,06	0,00	8,00
DEC-ESP	Decapado especial de resina	0,48	0,00	0,00	0,00
DEC-MNC	Decapado de resina en Tepla MNC	0,24	0,00	0,00	0,00
DEC-RESI	Decapado de resina	0,24	0,00	0,00	4,00
DESP-MNC	Decapado especial de resina en Tepla MNC	0,48	0,00	0,00	0,00
DNIT-ING	Depósito no estàndar de nitruro de silicio LPCVD	11,30	0,00	14,41	25,00
DNITAAA	DEP. ESTANDAR DE 1800Å SI3N4	11,30	0,00	14,41	25,00
DNITAAAB	DEP. ESTANDAR DE 1175Å SI3N4	11,30	0,00	12,72	25,00
DNITXXX	DEP. SEMIESTANDARD DE SI3N4	11,30	0,00	14,41	25,00
DNTPLOXF	Depósito de nitruro de silicio PECVD en obleas contaminadas	2,62	0,00	0,55	8,00
DNTPLXXX	DEPOSICION DE NITRURO PECVD	53,79	0,00	15,96	15,00
DOXF-ING	Depósito PECVD de Ingeniería en obleas contaminadas	2,62	0,00	1,17	8,00
DOXNTAAA	DEPOSICION PASIVACION PECVD	0,00	0,00	30,57	18,00
DOXNTXXX	Depósito de pasivación de grosor variable	53,79	0,00	14,26	15,00
DOXPLOXF	Depósito de óxido de silicio PECVD en obleas contaminadas	2,62	0,00	0,69	8,00
DOXPLXXX	DEPOSICION DE OXIDO PECVD	53,79	0,00	9,87	15,00
DPASXOXF	Depósito de óxido y nitruro de Si PECVD en obleas contaminadas	2,62	0,00	1,17	8,00
DPOL-ING	Depósito no estàndar de Polisilicio por LPCVD	13,48	0,00	9,62	25,00
DPOLAAA	DEPOSICION DE 4800Å DE POLY	13,48	0,00	7,46	25,00
DPOLAAAB	DEPOSICION DE 3500Å DE POLY	13,48	0,00	7,56	25,00
DPOLSENA	DEP. 1µ POLY (580°C/350MTORR)	35,53	0,00	0,00	0,00
DPOLXXX	DEPOSICION SEMIESTAND. DE POLY	13,48	0,00	7,46	25,00
DSIPLOXF	Depósito de silicio amorfo PECVD en obleas contaminadas	2,62	0,00	0,29	0,00
ESPECIAL	Proceso o etapa no estàndar (por SB)	0,00	0,00	0,00	0,00
FDWL-CON	Conversió d'arxius gds a lic pel DWL66fs (Heidelberg làser)	0,00	0,00	0,00	0,00
FDWL-ING	Litografia per DWL LÀSER	0,00	0,00	0,00	0,00
FEIN-ESP	Proceso o etapa no estandar fuera de la Sala Blanca	0,00	0,00	0,00	0,00
FESP-SIC	FOTOLITOGRAFIA DE OBLEAS DE SIC	18,19	1,89	0,00	0,00
FESPECIA	Fotolitografia especial sense seqüència d'aliniament predefinida	18,19	1,89	0,00	0,00
FIN-OBL	OBLEAS TERMINADAS	0,00	8,00	0,00	4,00
FINAL	FINAL DEL RUN EN SB	0,00	8,00	0,00	4,00
FLDFAAB	FLUIDIFICACION OX.INTERNIVEL	28,78	0,00	0,00	0,00
FOTO-ALH	Fotolitografia sobre capas de aluminio con resina estàndar, para grabado húmedo	0,00	5,51	0,00	0,00
FOTO-DWL	Fotolitografia LÀSER amb gruix resina 0'9µm OiD-620-9	0,00	0,00	0,00	0,00
FOTO-ESP	Fotolitografia no estandar con proceso predefinido por usuario	18,19	1,89	0,00	4,00
FOTO-FAL	Fotolitografia dummy para preservar secuencia de alineamiento	0,00	0,00	0,00	24,00

FOTO-FCD	Fotolitografía estándar en obleas a doble cara sin protección de dorso	14,46	5,51	0,00	4,00
FOTO-FKD	Fotolitografía con alineamiento entre caras. SIN protección de cara opuesta	14,46	5,51	0,00	0,00
FOTO-FKR	Fotolitografía con alineamiento entre caras, con protección de cara opuesta	14,46	7,40	0,00	0,00
FOTO-FRD	Fotolitografía a 1 cara para obleas pulidas por ambas caras, con protección de c	14,46	7,40	0,00	0,00
FOTO-ING	Fotolitografía en condiciones no estándar acordadas con ingeniería	0,00	44,68	0,00	0,00
FOTO-MNC	Fotolitografía MNC, 1 ó 2 cares.Replicació dels procès CMOS.	32,65	1,89	0,00	4,00
FOTO-SAR	Fotolitografía sobre aluminio, con resina antireflectante. Apta para grabado sec	0,00	6,13	0,00	0,00
FOTO-STA	Fotolitografía con stepper para grabado seco de Al	3,35	6,13	0,00	0,00
FOTO-STN	Fotolitografía estándar con stepper (Proyección)	3,35	5,51	0,00	0,00
FOTO-STU	Fotolitografía estándar, alineamiento a 1 cara	0,00	5,51	0,00	0,00
GGIR-ESP	GRAVAT SEC NO ESTANDAR EN EL GIR 160.	32,40	0,28	0,00	0,00
GGIR-ING	GRABADO SECO INGENIERIA EN GIR 160	32,40	0,28	0,00	0,00
GHUM-ESP	Grabado húmedo especial	53,06	0,00	0,00	0,00
GHUM-ING	Grabado húmedo de ingeniería	53,06	0,00	0,00	0,00
HOLD-EQP	Paro de la secuencia del run cuando un equipo requerido inminentemente está en r	0,00	0,00	0,00	0,00
HOLDICTS	Parada de fabricación por ICTS	0,00	0,00	0,00	0,00
HOLDRESP	Parada de fabricación causada o solicitada por el responsable	0,00	0,00	0,00	0,00
ICAMPC25	I.I. DE CAMPO (CMOS-25)	6,33	0,00	0,00	4,00
IF&DNC25	I.I. REGIONES N++ (CMOS-25)	6,33	0,00	0,00	4,00
IF&DPC25	I.I. REGIONES P++	6,33	0,00	0,00	4,00
IGATEC25	I.I. AJUSTE VT (CMOS-25)	6,33	0,00	0,00	4,00
IMIMCING	Implantación en el IMC-210rd	10,55	0,00	0,00	4,00
IMP-HIGH	Implantacion ionica de alta dosis	6,33	0,00	0,00	4,00
IMP-LOW	Implantacion ionica de dosis baja	6,33	0,00	0,00	4,00
IMP-SUP	Implantacion ionica de muy alta dosis	6,33	0,00	0,00	4,00
IMPL-ING	Implantación iónica de ingeniería	6,33	0,00	0,00	4,00
INICIO	PREPARAR EL INICIO DEL RUN	0,00	0,00	0,00	0,00
IPOUNC25	I.I. PARA POZO N (CMOS-25)	6,33	0,00	0,00	4,00
IPOUPC25	I.I. PARA POZO P (CMOS-25)	6,33	0,00	0,00	4,00
MARC-EAL	OBL. EPI. CMOS25	0,00	55,00	0,00	0,00
MARC-EAO	OBL. EPI. CMOS175	0,00	55,00	0,00	0,00
MARC-ESP	OBLEAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
MARC-EXT	OBLEAS EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
MARC-GEN	OBLEAS VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MARC-NAA	OBLEAS N, 1-12 OHM.CM	0,00	22,66	0,00	0,00
MARC-PAA	OBLEAS P, 4-40 OHM.CM	0,00	22,30	0,00	0,00
MARC-PAC	OBLEAS P, 0.1-1.4 OHM.CM	0,00	22,30	0,00	0,00
MARC-POT	OBLEAS PROYECTOS DE POTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MARC-PXA	OBLEAS P,4-40OHM CM,300µ SEN..	0,00	18,00	0,00	0,00
MARC-PXB	OBL. P, 10-20OHM.CM 500µ 2 PUL	0,00	51,50	0,00	0,00
MARC-SEN	OBLEAS PROYECTOS DE SENSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
MARC-SOI	OBLEAS TIPO SOI	0,00	0,00	0,00	0,00
MARC-TEC	OBLEAS TECNOLOGIA DE SILICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCAR	MARCAR OBLEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCN150	OBLEAS N, 1-30OHM.CM 150mm 675µm	0,00	26,00	0,00	50,00
MARCPY05	OBLEAS PYREX 0,5 mm/con flat	0,00	35,00	0,00	25,00
MAU-UING	Deposición por evaporación de capas o multicapas en las que se requiera Au.	13,00	38,00	0,00	4,00
MEALCU	DEPOSICION DE AL/CU	14,00	0,63	0,00	0,00
MEALSICU	DEPOSICION DE AL/SI/CU	14,00	0,63	0,00	0,00
MES-ESP	MEDIDAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
MES-NANO	MEDIR EN EL NANOSPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
MES-PRO	Medida de grosor de obleas mediante el uso del equipo Proforma300	0,00	0,00	0,00	0,00
MEV-UING	Deposición por evaporación de cualquier capa o multicapa excepto de Au o de Pt.	17,72	2,00	0,00	4,00
MEVPKING	Evaporación de Ti, Al o Cr.	16,80	6,50	0,00	0,00
MK500ING	metalización en sputtering KS500C	0,00	11,91	14,04	4,00
MK800ING	Metalizacion en sputtering KS800H	0,00	11,91	14,04	4,00

MPT-UING	Deposición por evaporación de capas o multicapas en las que se requiera usar Pt.	23,70	42,40	0,00	4,00
MRC-ING	DEPOSITO MRC-MCM POR INGENIERO	0,00	0,00	65,00	6,00
MRCTNING	Deposito de Ti o Ni por ingeniero	0,00	0,00	25,00	6,00
MSKOHING	Micromecanizado del silicio en volumen en KOH en trozos o obleas especiales	0,00	0,00	68,80	6,00
MSKOHMNC	Micromecanizado del silicio en volumen mediante KOH en obleas contaminadas	0,00	0,00	137,60	6,00
MSKOHXXX	Micromecanizado del silicio en volumen en KOH para obleas limpias	0,00	0,00	68,80	6,00
MSLIFING	Estructuración de capas de metal sin grabado químico. Procesos especiales	0,00	16,95	0,00	4,00
MSLIFTOF	Estructuración de metal sin grabado químico	0,00	10,17	0,00	4,00
MST-ESP	Procesado no estándar de muestras en el laboratorio de microsistemas	0,00	10,04	0,00	4,00
MSTMHING	Micromecanizado del silicio en volumen en TMAH en trozos o obleas especiales	0,00	0,00	605,76	6,00
MSTMHMNC	Grabado anisótropo de silicio en TMAH para obleas contaminadas	0,00	0,00	605,76	6,00
MSTMHXXX	Micromecanizado del silicio en volumen mediante TMAH en obleas limpias	0,00	0,00	302,88	6,00
MZ550ING	Metalización de Al de ingeniería en el sputtering Leybold Z550	0,00	11,91	14,04	4,00
NET1-SIC	Limpieza general para obleas de SiC	55,16	0,00	0,00	0,00
NET2-SIC	Limpieza general para obleas de SiC previa a una oxidación	77,30	0,00	0,00	0,00
NET3-SIC	Limpieza general para obleas de SiC previa a un recocido a alta temperatura	73,16	0,00	0,00	0,00
NET4-SIC	Limpieza general para obleas de SiC al inicio de run	79,04	0,00	0,00	0,00
NETE-SIC	LIMPIEZA ESPECIAL DE SIC Y/O GAN	208,96	0,00	0,00	0,00
NETG-DIS	Limpieza con disolventes (Acetona / IPA)	47,10	0,00	0,00	0,00
NETG-ESP	LIMPIEZA ESPECIAL	53,06	0,00	0,00	0,00
NETG-GEN	Limpieza general	58,04	0,00	0,00	0,00
NETG-HF	Limpieza general con HF	19,44	0,00	0,00	0,00
NETG-ING	Limpieza húmeda de ingeniería	53,06	0,00	0,00	0,00
NETG-MNC	Limpieza general en MNC	67,91	0,00	0,00	0,00
NETG-RCA	Limpieza RCA	77,35	0,00	12,55	25,00
NETG-SIC	LIMPIEZA GENERAL PARA OBLEAS DE SIC	208,96	0,00	0,00	0,00
NETG-SIM	Limpieza simple	53,06	0,00	0,00	0,00
NETGH2OC	LIMPIEZA CON AGUA OBLEAS-MET	28,94	0,00	0,00	0,00
NETGH2OS	LIMPIEZA CON AGUA SIN METAL	28,94	0,00	0,00	0,00
NETHFMNC	Limpieza general con HF al 5 % en MNC	17,73	0,00	0,00	0,00
NETS-MNC	Limpieza simple en MNC	51,35	0,00	0,00	0,00
NH2O-MNC	Limpieza con agua en MNC	27,23	0,00	0,00	0,00
O&R-ESP	OXIDACION O RECOCIDO ESPECIAL	15,18	0,00	78,26	24,00
O&R-ING	Proceso de oxidación o recocido de ingeniería	15,18	0,00	78,26	24,00
OBLEAS	INCORPORAR OBLEAS DEL RESPONS.	0,00	0,00	0,00	0,00
ODPP0AAA	DOPADO POC13 DEL POLY 0 CMOS25	20,41	0,00	10,31	24,00
OFLDFAAD	FLUID.OXIDO INTERNIVEL CMOS25	15,18	0,00	13,99	24,00
OHC-0780	OXIDACION DE PUERTA DE 780A	15,18	0,00	31,66	49,00
OHC-1000	OXID.DE 1000Å A 950°C	6,61	0,00	18,50	49,00
OHC-1M	OXIDACION DE 1 µM A 1100°C	6,61	0,00	38,87	49,00
OHC-1M5	OXIDACION DE 1.5 MICRAS	6,61	0,00	61,71	49,00
OHC-4000	OXIDO HUMEDO DE 4000Å A 1100°C	6,61	0,00	22,87	49,00
OHC-8000	OXIDACION HUMEDA DE 8000Å	6,61	0,00	31,87	49,00
OHC-XXX	OXIDO VARIABLE A 1100°C	6,61	0,00	38,87	49,00
OPOC4800	DOPAJE POCL3 DE 4800Å DE POLY	20,41	0,00	10,51	24,00
OPOC6000	DOPADO POC13 DE 6000Å DE POLY	20,41	0,00	11,33	24,00
OPOCSENA	DOPADO POC13 DEL SILICIO	35,20	0,00	0,00	0,00
ORCALAAA	RECOCIDO ALUMINIO CMOS25	0,77	0,00	6,26	50,00
ORECNEUT	RECOCIDO A DIF. TEMPERATURAS	15,18	0,00	19,79	24,00
ORECOXID	RECOCIDO A DIF. TEMPERATURAS	15,18	0,00	36,94	24,00
OREPOAAA	RECOCIDO DE POZO CMOS25	15,18	0,00	47,17	24,00
OSC-0300	OXID.SECA DE 300Å A 1000°C	15,18	0,00	22,08	24,00
OSC-0500	OXID. SECA DE 500Å A 1000°C	15,18	0,00	45,36	24,00
OX800AAA	OXID. SECA A 800°C	38,91	0,00	0,00	0,00
OX800DLA	OXID. DILUIDA A 800°C	38,91	0,00	0,00	0,00
OXCMAAA	OXIDACION DE CAMPO (CMOS25)	6,61	0,00	79,40	49,00

OXCMAAB	OXIDACION DE CAMPO 7500Å	84,10	0,00	0,00	0,00
OXINAAA	OXIDO INICIAL CMOS25	15,18	0,00	23,49	24,00
OXNT-RIE	ATAC PER RIE DE LA PASSIVACIO	64,80	0,34	0,00	0,00
OXPDAAA	OXIDO DE PEDESTAL CMOS25	15,18	0,00	38,94	24,00
OXPOAAA	OXIDACION DEF. POZO N (CMOS25)	6,61	0,00	18,67	24,00
OXPTAAA	OXIDO DE PUERTA CMOS25	15,18	0,00	51,97	49,00
OXPTAAB	OXIDACION DE PUERTA.250Å	72,80	0,00	0,00	0,00
OXPVAAA	OXIDO SACRIFICIAL 920Å CMOS25	15,18	0,00	95,64	24,00
P601-ESP	Grabado de diferentes materiales en el DRIE ALCATEL 601E	5,00	40,11	0,00	0,00
P601-ING	Grabado de diferentes materiales a múltiples profundidades en Alcatel 601-E.	22,57	51,50	0,00	0,00
P601CONT	Grabado profundo de contactos en el Alcatel 601-E	5,00	51,50	0,00	0,00
P601DEEP	Grabado profundo de silicio en el alcatel 601-E	5,00	40,11	0,00	0,00
P601POLI	Grabado de polisilicio en el Alcatel 601-E	22,57	0,51	0,00	0,00
PAMI-ESP	Grabado de diferentes materiales en el AMI ETCH P-5000	32,40	0,33	0,00	0,00
PAMINPAS	Grabado de nitruro de silicio de pasivación en el AMI ETCH P-5000 en obleas CMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PAMIOPAS	Grabado de óxido de pasivación en el AMI ETCH P-5000 en obleas CMOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
PAMS-ESP	Grabado de diferentes materiales en el ALCATEL AMS-110 DE en obleas MNC	5,00	25,91	0,00	0,00
PAMS-ING	Grabado seco de diferentes capas para obleas MNC	11,29	25,91	0,00	0,00
PAMS-OX	Grabado de dielectricos para obleas MNC	11,29	0,77	0,00	4,00
PAMSDEEP	Grabado profundo de Silicio en obleas MNC en Alcatel AMS 110	5,00	25,91	0,00	4,00
PGIDPC25	DECAPADO EN SECO DE POLISILICIO CARA POSTERIOR CMOS25 EN GIR 160	22,57	0,14	0,00	0,00
PGIDPXXX	DECAPADO EN SECO DE POLISILICIO DE LA CARA POSTERIOR EN GIR 160	22,57	0,14	0,00	0,00
PGINISEN	GRABADO SECO DE NITRURO DE SILICIO PARA SENSORES EN GIR 160	19,69	0,20	0,00	0,00
PGINIXXX	GRABADO SECO DE NITRURO DE SILICIO EN GIR 160	19,69	0,16	0,00	0,00
PGIOPC25	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE PASIVACION EN GIR 160	32,40	0,34	0,00	0,00
PGIOXGUI	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE SILICIO PARA GUIAS EN GIR 160	32,40	1,08	0,00	0,00
PGIOXXX	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE SILICIO EN GIR 160	32,40	0,28	0,00	0,00
PGIPOXXX	GRABADO EN SECO DE POLISILICIO EN GIR 160	22,19	0,18	0,00	0,00
PGISPC25	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE SILICIO PARA "SPACER" EN GIR 160	0,00	0,74	0,00	0,00
PGIVIC25	GRABADO SECO DE OXIDO DE SILICIO DE LAS VIAS EN GIR 160	0,00	0,74	0,00	0,00
POXF-1AL	Grabado seco de Al entre 0,5 - 1,5 um en Oxford Plasmalab System 100	97,17	0,57	0,00	4,00
POXF-2AL	Grabado seco de Al entre 1,5 - 3 um de Al en Oxford Plasmalab System 100	97,17	1,14	0,00	4,00
POXF-ESP	Grabado seco no standard en Oxford Plasmalab System 100	97,17	0,57	0,00	4,00
POXF-ING	Grabado de ingeniería de Aluminio en el Oxford Plasmalab System 100	97,17	1,14	0,00	4,00
PQ1NIC25	GRABADO NITRURO CMOS25	39,38	0,06	0,00	0,00
PQ2ALC25	GRABADO DE AL DEL CMOS 25	64,78	1,09	0,00	0,00
PRE-GRAV	BARREL RES.DE MEJORA DE GRAV.	0,24	0,00	0,00	0,00
PREG-MNC	Barrel de resina para mejorar el grabado en MNC	0,24	0,00	0,00	0,00
PROC-URG	PROCEDIMIENTO DE URGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCRECU	Procedimiento de Recuperación de un run o subsanación de un defecto	0,00	0,00	0,00	0,00
PROT-BII	Net, 1ó2cares. D.U.V+ Bake fins 180°C de resina 6512. Foto previa	0,00	0,00	0,00	0,00
PROT-GEN	Net,1o2cares. Depositar resina 6512 sobre cara pulida+Bake 125°C	0,00	2,20	0,00	0,00
PROT-GHU	Net, 1ó2 cares. Només Bake 125°C Resina 6512. Foto previa	0,00	0,00	0,00	0,00
PROT-SIC	DEPOSITO DE RESINA PARA PROTECCION EN SIC	0,00	1,89	0,00	0,00
QDAL-SIC	DECAPADO DE ALUMINIO EN MUESTRAS SIC	27,66	0,00	0,00	0,00
QDNITC25	Decapado de nitruro CMOS 25	78,30	0,00	0,00	0,00
QDNITXXX	Decapado de nitruro	78,30	0,00	0,00	0,00
QDOX1C25	Decapado del 1er óxido de CMOS-25	32,46	0,00	0,00	0,00
QDOX2C25	Decapado del 2º óxido del CMOS-25	32,46	0,00	0,00	0,00
QDOXDXXX	Decapado de óxido dopado	43,03	0,00	0,00	0,00
QDOXNC25	Decapado del oxi-nitruro	32,46	0,00	0,00	0,00
QDOXTXXX	Decapado de óxido térmico sin Al	32,46	0,00	0,00	0,00
QDPSGC25	DECAPADO DEL PSG DEL CMOS-25	35,12	0,00	0,00	0,00
QDRACMNC	Decapado de resina en ácido en MNC	75,49	0,00	0,00	0,00
QDRACXXX	Decapado de resina en ácido	77,20	0,00	0,00	0,00
QDRDIXXX	Decapado de resina en disolvente	92,48	0,00	0,00	0,00

QGACSXXX	Grabado de Al/0.5% Cu/0.75% Si	67,36	0,00	0,00	0,00
QGAL-SIC	GRABADO DE ALUMINIO CON MASCARA DE RESINA EN SIC	27,66	0,00	0,00	0,00
QGALCXXX	Grabado de Al/0.5% Cu	42,12	0,00	0,00	0,00
QGALSXXX	Grabado de AL/1% Si	67,36	0,00	0,00	0,00
QGOX-SIC	Grabado de óxido con máscara de resina sobre SiC	18,00	0,00	0,00	0,00
QGOX-XXX	Grabado de óxido sin máscara	32,46	0,00	0,00	0,00
QGOX0300	Grabado de óxido de 300 Å	32,46	0,00	0,00	0,00
QGOX1C25	Grabado de óxido sacrificial	32,46	0,00	0,00	0,00
QGOX2500	Grabado de óxido de 2500 Å	32,46	0,00	0,00	0,00
QGOX8000	Grabado de óxido de 8.000Å	32,46	0,00	0,00	0,00
QGOXDXXX	Grabado de óxido dopado	43,03	0,00	0,00	0,00
QGOXNXXX	Grabado de óxido con máscara de nitruro	32,46	0,00	0,00	0,00
QGOXRXXX	Grabado de óxido con máscara de resina	32,46	0,00	0,00	0,00
QPRMEC25	Paso previo a la metalización	45,53	0,00	0,00	0,00
QREDUC25	Limpieza pre-deposición de poli	45,53	0,00	0,00	0,00
QSC-ING	Ataque húmedo en MNC por el ingeniero	52,38	0,00	0,00	0,00
QSCALMNC	Grabado húmedo de Al en MNC	52,60	0,00	0,00	0,00
QSCAUMNC	Grabado húmedo de Au	27,23	0,00	0,00	0,00
QSCDRMNC	Decapado de resina en húmedo con MNC	106,55	0,00	0,00	0,00
QSCNGMNC	LIMPIEZA CON AGUA CON M.N.C.	22,40	0,00	0,00	0,00
QSCNIMNC	Grabado húmedo de Ni en MNC	30,74	0,00	0,00	0,00
QSCOXMNC	Grabado de óxido en MNC	52,38	0,00	0,00	0,00
QSCPMNC	Paso previo a la metalización MNC	43,82	0,00	0,00	0,00
QSCTCMNC	Grabado tricapa Ti/Ni/Au MCM	38,63	0,00	0,00	0,00
QSCTIMNC	Grabado húmedo de Ti con MNC	35,12	0,00	0,00	0,00
REC-ALU	RECOCIDO ALUMINIO A 450°C	0,77	0,00	2,69	50,00
REPOAAB	RECOCIDO DE POZO A 1150°C	132,37	0,00	0,00	0,00
RTPA-ING	Recuit/oxidació a l'equip AS-ONE-200	0,00	5,00	0,00	1,00
RTPD-ING	Proces de recuita rapida o RTCVD a l'equip AS-Master 2000	10,51	0,00	0,00	1,00

## ANEXO 1

### Tarifas de Procesos por encomienda actualizadas a Diciembre 2015

ETAPA	DESCRIPCION	C-Run	C-Oblea	C-Paso	Obleas Paso
AEBL-ING	Litografia per EBL a l'equip RAITH150TWO	26	25	0	0
AFIB-ING	Nanoestructuració al FIB (talls, seccions, lamel·les, edició circuits...)	38	0	0	0
ALDD-ALM	Atomic layer deposition of dielectrics - Standard deposition of aluminum oxide	10	10	0	0
ALDD-HAF	Atomic layer deposition of dielectrics - Standard deposition of hafnium oxide	10	10	0	0
ALDD-ING	Dipòsit de capes dielèctriques per Atomic Layer Deposition (ALD)	10	20	0	0
AMRIEING	Gravat RIE no estàndar a l'AMI-ETCH	10	10	0	0
ANIL-ING	Nano-impressió amb el NIL d'Obducat de 4	5	1.5	0	0
ASEM-ING	Inspecció SEM a l'equip LEO1530	17	0	0	0
BPSGAAB	DEPOSICION DE BPSG(CMOS175)	0	0	87.03	4
BRUC-ING	Oxidació o recuita no estàndar al forn de difusió BRUCE	183.92	0	0	0
CMOS-MNC	Transferència de les mostres a porta-mostres MNC	0	0	0	0
DAMI-ING	Dipòsit de dielèctrics no estàndar per PECVD a l'AMIDEP	9	2.19	0	8
DAMINTXX	Depósito de nitruro PECVD basado en silano	9	1.13	0	8
DAMIOX11	Depósito de óxido PECVD TEOS1:1	9	1.03	0	8
DAMIOX21	Deposición de óxido PECVD TEOS ratio 2:1	9	1.06	0	8
DAMIOXC1	Deposición de óxido con silano PECVD	9	1.05	0	8
DAMIPASX	Depósito PECVD de óxido TEOS y nitruro para pasivación	9	2.19	0	8
DBPSGAAA	DEPOSICION 1.3µM BPSG (CMOS25)	0	0	87.03	4
DBPTEOSA	DEPOSICION 1.3µM BPTEOS(CMOS25)	30	30	0	0
DBPTEOSX	Deposición de óxido dopado PECVD TEOS de grosores variables	9	1.06	0	8
DEC-ESP	Decapado especial de resina	1.5	0	0	0
DESP-MNC	Decapado especial de resina en Tepla MNC	0.48	0	0	0
DEC-NIT	ERROR/NO HA EXISTIDO ESTE CODI	0	0	0	0
DEC-RESI	Decapado de resina	0.75	0	0	0
DNIT-ING	Depósito no estàndar de nitruro de silicio LPCVD	37.29	0	0	0
DNITAAA	DEP. ESTANDAR DE 1800Å SI3N4	35.26	0	0	0
DNITAAAB	DEP. ESTANDAR DE 1175Å SI3N4	32.62	0	0	0
DNITXXX	DEP. SEMIESTANDARD DE SI3N4	35.26	0	0	0
DNTPLOXF	Depósito de nitruro de silicio PECVD en obleas contaminadas	10	0	20	8
DNTPLXXX	DEPOSICION DE NITRURO PECVD	0	0	25.52	18
DOXF-ING	Depósito PECVD de Ingeniería en obleas contaminadas	10	0	20	8
DOXNTAAA	DEPOSICION PASIVACION PECVD	0	0	30.57	18
DOXNTXXX	Depósito de pasivación de grosor variable	0	0	30.57	18
DOXPLOXF	Depósito de óxido de silicio PECVD en obleas contaminadas	10	0	20	8
DOXPLXXX	DEPOSICION DE OXIDO PECVD	0	0	15.22	18
DPASXOXF	Depósito de óxido y nitruro de Si PECVD en obleas contaminadas	10	0	20	8
DPLA-ING	Depósito no estàndar de capas dielèctriques en el T12 por PECVD	0	0	40	18
DPOL-ING	Depósito no estàndar de Polisilicio por LPCVD	35.53	0	0	0
DPOLAAA	DEPOSICION DE 4800Å DE POLY	25.74	0	0	0
DPOLAAB	DEPOSICION DE 3500Å DE POLY	24.76	0	0	0
DPOLSENA	DEP. 1µ POLY (580°C/350MTORR)	35.53	0	0	0
DPOLXXX	DEPOSICION SEMIESTAND. DE POLY	25.74	0	0	0
DPP1AAB	DOPAJE DE POLY CON POCL3	22.72	0	0	0
DPYR-ING	A REALIZAR POR EL INGENIERO	0	0	87.03	4
DPYR-PSG	DEPOSICION DE 1µ OXIDO DOPADO	0	0	46.11	4
DPYR-UND	DEPOSICION DE 1µ OXIDO NO DOP.	0	0	56.51	4
DPYR-XXX	DEPOSICION ESP. DE OXIDO PYROX	0	0	87.03	4
DSIPLOXF	Depósito de silicio amorfo PECVD en obleas contaminadas	10	20	0	0
ESPECIAL	Proceso o etapa no estàndar (por SB)	0	0	0	0

FEIN-ESP	Proceso o etapa no estandar fuera de la Sala Blanca	0	0	0	0
FESP-SIC	FOTOLITOGRAFIA DE OBLEAS DE SIC	58.82	4.14	0	0
FESPECIA	Fotolitografía especial sense seqüència d'aliniament predefinida	58.82	14.5	0	0
FIN-OBL	OBLEAS TERMINADAS	0	8	0	0
FINAL	FINAL DEL RUN EN SB	0	8	0	0
FOTO-ALH	Fotolitografía sobre capas de aluminio con resina estándar, para grabado húmedo	0	10.36	0	0
FOTO-ESP	Fotolitografía no estandar con proceso predefinido por usuario	58.82	14.5	0	0
FOTO-FCD	Fotolitografía estándar en obleas a doble cara sin protección de dorso	58.82	5.92	0	0
FOTO-FKD	Fotolitografía con alineamiento entre caras, SIN protección de cara opuesta	58.82	10.06	0	0
FOTO-FKR	Fotolitografía con alineamiento entre caras, con protección de cara opuesta	58.82	14.2	0	0
FOTO-FPU	ELIMINADA . Es substitueix per una FOTO * i una PROT	0	13.67	0	0
FOTO-FRD	Fotolitografía a 1 cara para obleas pulidas por ambas caras, con protección de c	58.82	10.06	0	0
FOTO-ING	Fotolitografía en condiciones no estándar acordadas con ingeniería	0	75.97	0	0
FOTO-MNC	Fotolitografía MNC, 1 ó 2 cares.Replicació dels procès CMOS.	58.82	14.5	0	0
FOTO-SAR	Fotolitografía sobre aluminio, con resina antireflectante. Apta para grabado sec	0	11.36	0	0
FOTO-SPA	FOTO STEPPER ANTI-REFLEC	7.02	10.67	0	0
FOTO-SPR	ELIMINADA Era per el Stepper Canon . Una máquina ja desballestada	7.02	9.78	0	0
FOTO-STA	Fotolitografía con stepper para grabado seco de Al	7.02	10.36	0	0
FOTO-STN	Fotolitografía estándar con stepper (Proyección)	7.02	11.36	0	0
FOTO-STU	Fotolitografía estándar, alineamiento a 1 cara	0	10.36	0	0
GCA-ING	FOTO EN MCM POR EL INGENIERO	4160	1781	0	0
GGIR-ESP	GRAVAT SEC NO ESTANDAR EN EL GIR 160.	32.4	0.28	0	0
GGIR-ING	GRABADO SECO INGENIERIA EN GIR 160	32.4	0.28	0	0
GHUM-ESP	Grabado húmedo especial	168.4	0	0	0
GHUM-ING	Grabado húmedo de ingeniería	168.4	0	0	0
HEX-ING	GRABADO RIE-MCM POR INGENIERO	454	0	0	0
ICAMPC25	I.I. DE CAMPO (CMOS-25)	16.49	0	0	0
IF&DNC25	I.I. REGIONES N++ (CMOS-25)	16.92	0	0	0
IF&DPC25	I.I. REGIONES P++	16.49	0	0	0
IGATEC25	I.I. AJUSTE VT (CMOS-25)	16.49	0	0	0
IMIMCING	Implantación en el IMC-210rd	25	0	0	0
IMP-HIGH	Implantacion ionica de alta dosis	27	0	0	0
IMP-LOW	Implantacion ionica de dosis baja	22	0	0	0
IMP-SUP	Implantacion ionica de muy alta dosis	37	0	0	0
IMPL-B	IMPLANTACION I. DE BORO	16.49	0	0	0
IMPL-BF2	IMPLANTACION IONICA DE BF2	15.29	0	0	0
IMPL-ESP	IMPLANTACION ESPECIAL	25	0	0	0
IMPL-ING	Implantación iónica de ingeniería	25	0	0	0
IMPL-P	IMPLANTACION I. DE FOSFORO	16.92	0	0	0
INICIO	PREPARAR EL INICIO DEL RUN	0	0	0	0
IPOUNC25	I.I. PARA POZO N (CMOS-25)	16.92	0	0	0
IPOUPC25	I.I. PARA POZO P (CMOS-25)	16.49	0	0	0
M3120ING	A REALIZAR POR EL INGENIERO	53539	0	0	0
M3180ING	Metalización de ingeniería en el sputtering Varian 3180	14.04	2.5	0	0
MA610-PT	DEPOSICION DE PT	0	56.34	14.04	8
MA610-XX	DEPOSICIONES DIVERSAS	0	22.99	14.04	8
MA610ING	A REALIZAR POR EL INGENIERO	0	56.34	14.04	8
MARC-EAL	OBL. EPI. CMOS25	0	65.7	0	0
MARC-EAO	OBL. EPI. CMOS175	0	68.75	0	0
MARC-ESP	OBLEAS ESPECIALES	0	0	0	0
MARC-EXT	OBLEAS EXTERIORES	0	0	0	0
MARC-GEN	OBLEAS VARIAS	0	0	0	0
MARC-NAA	OBLEAS N, 1-12 OHM.CM	0	24.75	0	0

MARC-PAA	OBLEAS P, 4-40 OHM.CM	0	24.75	0	0
MARC-PAC	OBLEAS P, 0.1-1.4 OHM.CM	0	24.75	0	0
MARC-POT	OBLEAS PROYECTOS DE POTENCIA	0	0	0	0
MARC-PXA	OBLEAS P,4-40OHM CM,300µ SEN..	0	61.81	0	0
MARC-PXB	OBL. P, 10-20OHM.CM 500µ 2 PUL	0	50	0	0
MARC-SEN	OBLEAS PROYECTOS DE SENSORES	0	0	0	0
MARC-SOI	OBLEAS TIPO SOI	0	0	0	0
MARC-TEC	OBLEAS TECNOLOGIA DE SILICIO	0	0	0	0
MARCAR	MARCAR OBLEAS	0	0	0	0
MARCPY05	OBLEAS PYREX 0,5 mm/con flat	0	35	0	0
MAU-UIING	Deposición por evaporación de capas o multicapas en las que se requiera Au.	14.04	0	56.34	4
MEALCU	DEPOSICION DE AL/CU	14.04	0.63	0	0
MEALSICU	DEPOSICION DE AL/SI/CU	14.04	0.63	0	0
MES-ESP	MEDIDAS ESPECIALES	0	0	0	0
MES-NANO	MEDIR EN EL NANOSPEC	0	0	0	0
MET-ESP	METAL.LITZACIONES ESPECIALS	0	0	0	0
MET-VARI	DEPOSICIÓN DE AL + 1% SI	44946	0	0	0
MEV-UIING	Deposición por evaporación de cualquier capa o multicapa excepto de Au o de Pt.	14.04	11.91	0	0
MEVAC175	DEP. DE 1µM AL/SI/CU	14.04	0.63	0	0
MEVAC25	DEP. DE 1µM AL/CU	14.04	0.63	0	0
MEVADORS	METALIZACION DORSO AL/SI/CU	8.64	0.63	0	0
MEVPKING	Evaporación de Ti, Al o Cr.	14.04	11.91	0	0
MEVPUING	Deposición de materiales por evaporación.	14.04	11.91	0	0
MK500ING	metalización en sputtering KS500C	0	11.91	14.04	4
MK800ING	Metalizacion en sputtering KS800H	0	11.91	14.04	4
MPT-UIING	Deposición por evaporación de capas o multicapas en las que se requiera usar Pt.	14.04	0	56.34	4
MRC-ING	DEPOSITO MRC-MCM POR INGENIERO	0	0	65	6
MRCTNING	Deposito de Ti o Ni por ingeniero	0	0	25	6
MSKOHING	Micromecanizado del silicio en volumen en KOH en trozos o obleas especiales	0	0	92	2
MSKOHMNC	Micromecanizado del silicio en volumen mediante KOH en obleas contaminadas	0	0	92	2
MSKOHXXX	Micromecanizado del silicio en volumen en KOH para obleas limpias	0	0	57	2
MSLIFING	Estructuración de capas de metal sin grabado químico. Procesos especiales	0	18.16	0	4
MSLIFTOF	Estructuración de metal sin grabado químico	0	10.89	0	4
MST-ESP	Procesado no estándar de muestras en el laboratorio de microsistemas	0	10.06	0	0
MSTMHING	Micromecanizado del silicio en volumen enTMAH en trozos o obleas especiales	0	0	372	2
MSTMHMNC	Grabado anisótropo de silicio en TMAH para obleas contaminadas	0	0	372	2
MSTMHXXX	Micromecanizado del silicio en volumen mediante TMAH en obleas limpias	0	0	197	2
MZ550ING	Metalización de Al de ingeniería en el sputtering Leybold Z550	0	11.91	14.04	4
MZ550VID	METALIZACION DE VIDRIOS	8.64	11.91	0	0
NET1-SIC	Limpieza general para obleas de SiC	55.16	0	0	25
NET2-SIC	Limpieza general para obleas de SiC previa a una oxidación	77.3	0	0	25
NET3-SIC	Limpieza general para obleas de SiC previa a un recocido a alta temperatura	73.16	0	0	25
NET4-SIC	Limpieza general para obleas de SiC al inicio de run	79.04	0	0	25
NETE-SIC	LIMPIEZA ESPECIAL DE SIC Y/O GAN	208.96	0	0	0
NETG-DIS	Limpieza con disolventes (Acetona / IPA)	47.1	0	0	0
NETG-ESP	LIMPIEZA ESPECIAL	135.92	0	0	0
NETG-GEN	Limpieza general	135.92	0	0	0
NETG-HF	Limpieza general con HF	62.88	0	0	0
NETG-ING	Limpieza húmeda de ingeniería	135.92	0	0	0
NETG-MNC	Limpieza general en MNC	67.91	0	0	0
NETG-RCA	Limpieza RCA	77.35	0	12.55	25
NETG-SIC	LIMPIEZA GENERAL PARA OBLEAS DE SIC	208.96	0	0	0
NETG-SIM	Limpieza simple	92.33	0	0	0

NETGH2OC	LIMPIEZA CON AGUA OBLEAS-MET	19.29	0	0	0
NETGH2OS	LIMPIEZA CON AGUA SIN METAL	19.29	0	0	0
NETS-MNC	Limpieza simple en MNC	51.35	0	0	0
NH2O-MNC	Limpieza con agua en MNC	27.23	0	0	25
NIT-ING	A REALIZAR POR EL INGENIERO	6760	0	0	0
O&R-ESP	OXIDACION O RECOCIDO ESPECIAL	127.82	0	0	0
O&R-ING	Proceso de oxidación o recocido de ingeniería	127.82	0	0	0
OBLEAS	INCORPORAR OBLEAS DEL RESPONS.	0	0	0	0
ODPP0AAA	DOPADO POC13 DEL POLY 0 CMOS25	22.72	0	0	0
OFLDFAAD	FLUID.OXIDO INTERNIVEL CMOS25	42.65	0	0	0
OHC-0780	OXIDACION DE PUERTA DE 780A	59.37	0	0	0
OHC-1000	OXID.DE 1000Å A 950°C	34.8	0	0	0
OHC-1M	OXIDACION DE 1 µM A 1100°C	67.56	0	0	0
OHC-1M5	OXIDACION DE 1.5 MICRAS	104.95	0	0	0
OHC-4000	OXIDO HUMEDO DE 4000Å A 1100C°	41.59	0	0	0
OHC-8000	OXIDACION HUMEDA DE 8000Å	56.55	0	0	0
OHC-XXX	OXIDO VARIABLE A 1100°C	67.56	0	0	0
OPOC4800	DOPAJE POCL3 DE 4800Å DE POLY	22.39	0	0	0
OPOC6000	DOPADO POC13 DE 6000Å DE POLY	24.02	0	0	0
OPOCSENA	DOPADO POC13 DEL SILICIO	35.2	0	0	0
ORCALAAA	RECOCIDO ALUMINIO CMOS25	10.5	0	0	0
ORECNEUT	RECOCIDO A DIF. TEMPERATURAS	64.81	0	0	0
ORECOXID	RECOCIDO A DIF. TEMPERATURAS	105.47	0	0	0
OREPOAAA	RECOCIDO DE POZO CMOS25	95.49	0	0	0
OSC-0300	OXID.SECA DE 300Å A 1000°C	38.91	0	0	0
OSC-0500	OXID. SECA DE 500Å A 1000°C	83.53	0	0	0
OX800AAA	OXID. SECA A 800°C	38.91	0	0	0
OX800DLA	OXID. DILUIDA A 800°C	38.91	0	0	0
OXCMAAA	OXIDACION DE CAMPO (CMOS25)	127.82	0	0	0
OXCMAAB	OXIDACION DE CAMPO 7500Å	84.1	0	0	0
OXI-QUAD	GRABADO SECO DEL OXIDO DE SILICIO SIN PRESENCIA DE ALUMINIO	1.3	0.4	0	0
OXINAAA	OXIDO INICIAL CMOS25	48.59	0	0	0
OXNT-RIE	ATAC PER RIE DE LA PASSIVACIO	1.79	0.9	0	0
OXPDAAA	OXIDO DE PEDESTAL CMOS25	61.41	0	0	0
OXPOAAA	OXIDACION DEF. POZO N (CMOS25)	38.69	0	0	0
OXPTAAA	OXIDO DE PUERTA CMOS25	104.04	0	0	0
OXPTAAB	OXIDACION DE PUERTA.250Å	72.8	0	0	0
XPVAAA	OXIDO SACRIFICIAL 920Å CMOS25	132.65	0	0	0
P601-ESP	Grabado de diferentes materiales en el DRIE ALCATEL 601E	5	40.11	0	0
P601-ING	Grabado de diferentes materiales a múltiples profundidades en Alcatel 601-E.	10	20	0	0
P601CONT	Grabado profundo de contactos en el Alcatel 601-E	10	20	0	0
P601DEEP	Grabado profundo de silicio en el alcatel 601-E	10	20	0	0
P601POLI	Grabado de polisilicio en el Alcatel 601-E	10	20	0	0
PAMI-ESP	Grabado de diferentes materiales en el AMI ETCH P-5000	32.4	0.33	0	0
PAMS-ESP	Grabado de diferentes materiales en el ALCATEL AMS-110 DE en obleas MNC	5	25.91	0	0
PAMS-ING	Grabado seco de diferentes capas para obleas MNC	10	20	0	0
PAMS-OX	Grabado de dieléctricos para obleas MNC	11.29	0.77	0	4
PAMSDEEP	Grabado profundo de Silicio en obleas MNC en Alcatel AMS 110	5	25.91	0	4
PFAB-ING	PLASMA O2 MCM POR INGENIERO	1.28	0	0	0
PGIDPC25	DECAPADO EN SECO DE POLISILICIO CARA POSTERIOR CMOS25 EN GIR 160	0	0.9	0	0
PGIDPXXX	DECAPADO EN SECO DE POLISILICIO DE LA CARA POSTERIOR EN GIR 160	0	0.9	0	0
PGINISEN	GRABADO SECO DE NITRURO DE SILICIO PARA SENSORES EN GIR 160	0	0.94	0	0
PGINIXXX	GRABADO SECO DE NITRURO DE SILICIO EN GIR 160	0	0.94	0	0

PGIOPC25	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE PASIVACION EN GIR 160	0	0.66	0	0
PGIOXGUI	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE SILICIO PARA GUIAS EN GIR 160	0	1.21	0	0
PGIOXXX	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE SILICIO EN GIR 160	0	0.66	0	0
PGIPOXXX	GRABADO EN SECO DE POLISILICIO EN GIR 160	0	0.51	0	0
PGISPC25	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE SILICIO PARA "SPACER" EN GIR 160	0	0.74	0	0
PGVIC25	GRABADO SECO DE OXIDO DE SILICIO DE LAS VIAS EN GIR 160	0	0.74	0	0
POXF-1AL	Grabado seco de Al entre 0,5 - 1,5 um en Oxford Plasmalab System 100	97.17	0.57	0	4
POXF-2AL	Grabado seco de Al entre 1,5 - 3 um de Al en Oxford Plasmalab System 100	97.17	1.14	0	4
POXF-ESP	Grabado seco no standard en Oxford Plasmalab System 100	97.17	0.57	0	4
POXF-ING	Grabado de ingeniería de Aluminio en el Oxford Plasmalab System 100	97.17	1.14	0	4
PQ1NIC25	GRABADO NITRURO CMOS25	1.3	0.25	0	0
PQ1NIXXX	GRABADO NITRURO EN EL QUAD	1.3	0.25	0	0
PQ1P0C25	GRABADO DE POLI-0 DEL CMOS-25	1.3	0.42	0	0
PQ1P1C25	GRABADO DE POLI-1 DEL CMOS 25	1.3	0.53	0	0
PQ2AL3µM	GRABADO DE 3 µM AL EN EL QUAD	20.59	4	0	0
PQ2ALC25	GRABADO DE AL DEL CMOS 25	20.59	1.38	0	0
PQ2ALXXX	GRABADO DE AL EN EL QUAD	20.59	1.38	0	0
PRE-GRAV	BARREL RES.DE MEJORA DE GRAV.	0.49	0	0	0
PROC-URG	PROCEDIMIENTO DE URGENCIA	0	0	0	0
PROT-BII	Net, 162cares. D.U.V+ Bake fins 180°C de resina 6512. Foto previa	0	0	0	0
PROT-GEN	Net,1o2cares. Depositar resina 6512 sobre cara pulida+Bake 125°C	0	4.14	0	0
PROT-GHU	Net, 162 cares. Només Bake 125°C Resina 6512. Foto previa	0	0	0	0
PROT-PDU	Net, 1cara Depositar 6512 sobre cara rugosa+Bake 115°C	0	4.14	0	0
PROT-SIC	DEPOSITO DE RESINA PARA PROTECCION EN SIC	0	4.14	0	0
QDAL-SIC	DECAPADO DE ALUMINIO EN MUESTRAS SIC	101.43	0	0	0
QDNITC25	Decapado de nitruro CMOS 25	117.62	0	0	0
QDNITXXX	Decapado de nitruro	117.62	0	0	0
QDOX1C25	Decapado del 1er óxido de CMOS-25	57.02	0	0	0
QDOX2C25	Decapado del 2º óxido del CMOS-25	57.02	0	0	0
QDOXDXXX	Decapado de óxido dopado	94.54	0	0	0
QDOXNC25	Decapado del oxi-nitruro	57.02	0	0	0
QDOXTXXX	Decapado de óxido térmico sin Al	57.02	0	0	0
QDPSGC25	DECAPADO DEL PSG DEL CMOS-25	55.56	0	0	0
QDRACXXX	Decapado de resina en ácido	92.33	0	0	0
QDRDIXXX	Decapado de resina en disolvente	128.5	0	0	0
QGACSXXX	Grabado de Al/0.5% Cu/0.75% Si	168.4	0	0	0
QGAL-SIC	GRABADO DE ALUMINIO CON MASCARA DE RESINA EN SIC	101.43	0	0	0
QGALCXXX	Grabado de Al/0.5% Cu	101.43	0	0	0
QGALSXXX	Grabado de AL/1% Si	168.4	0	0	0
QGOX-SIC	Grabado de óxido con máscara de resina sobre SiC	57.02	0	0	0
QGOX-XXX	Grabado de óxido sin máscara	57.02	0	0	0
QGOX0300	Grabado de óxido de 300 Å	57.02	0	0	0
QGOX1C25	Grabado de óxido sacrificial	57.02	0	0	0
QGOX2500	Grabado de óxido de 2500 Å	57.02	0	0	0
QGOX8000	Grabado de óxido de 8.000Å	57.02	0	0	0
QGOXDXXX	Grabado de óxido dopado	94.54	0	0	0
QGOXNXXX	Grabado de óxido con máscara de nitruro	57.02	0	0	0
QGOXRXXX	Grabado de óxido con máscara de resina	57.02	0	0	0
QPRMEC25	Paso previo a la metalización	82.51	0	0	0
QREDUC25	Limpieza pre-deposición de poli	82.51	0	0	0
QSCALMNC	Grabado húmedo de Al en MNC	77.23	0	0	0
QSCAUMNC	Grabado húmedo de Au	120	0	0	0
QSCDRMNC	Decapado de resina en húmedo con MNC	187.85	0	0	0

QSCNGMNC	LIMPIEZA CON AGUA CON M.N.C.	18.67	0	0	0
QSCNIMNC	Grabado húmedo de Ni en MNC	77.23	0	0	0
QSCOXMNC	Grabado de óxido en MNC	77.23	0	0	0
QSCPMNC	Paso previo a la metalización MNC	74.42	0	0	0
QSCTCMNC	Grabado tricapa TI/NI/AU MCM	120	0	0	0
QSCTIMNC	Grabado húmedo de Ti con MNC	77.23	0	0	0
QUAD-ESP	GRAVAT SEC ESPECIAL. QUAD.	5	3	0	0
QUAD-ING	GRAB. SECO DE ING. EN QUAD	5	3	0	0
REC-ALU	RECOCIDO ALUMINIO A 450°C	8.31	0	0	0
REIMAAB	RECOCIDO POST IMPLANTACION	25.58	0	0	0
REPOAAA	RECOCIDO DE POZO	5539	0	0	0
REPOAAB	RECOCIDO DE POZO A 1150°C	132.37	0	0	0
SCP-ING	GRAB. HUMEDO DE ING. EN MCM	120	0	0	0
SFI-ING	DEPOSITO SFI-MCM POR INGENIERO	0	12.69	0	0
TAP-QUAD	GRAVAT D'OXID "TAPERETCH"	1.3	0.41	0	0

## ANEXO 1

### Tarifas de Procesos por encomienda actualizadas a Diciembre 2015

ETAPA	DESCRIPCION	C-Run	C-Oblea	C-Paso	Obleas Paso
AEBL-ING	Litografia per EBL a l'equip RAITH150TWO	26	25	0	0
AFIB-ING	Nanoestructuració al FIB (talls, seccions, lamel·les, edició circuits...)	38	0	0	0
ALDD-ALM	Atomic layer deposition of dielectrics - Standard deposition of aluminum oxide	10	10	0	0
ALDD-HAF	Atomic layer deposition of dielectrics - Standard deposition of hafnium oxide	10	10	0	0
ALDD-ING	Dipòsit de capes dielèctriques per Atomic Layer Deposition (ALD)	10	20	0	0
AMRIEING	Gravat RIE no estàndar a l'AMI-ETCH	10	10	0	0
ANIL-ING	Nano-impressió amb el NIL d'Obducat de 4	5	1.5	0	0
ASEM-ING	Inspecció SEM a l'equip LEO1530	17	0	0	0
BPSGAAB	DEPOSICION DE BPSG(CMOS175)	0	0	87.03	4
BRUC-ING	Oxidació o recuita no estàndar al forn de difusió BRUCE	183.92	0	0	0
CMOS-MNC	Transferència de les mostres a porta-mostres MNC	0	0	0	0
DAMI-ING	Dipòsit de dielèctrics no estàndar per PECVD a l'AMIDEP	9	2.19	0	8
DAMINTXX	Depósito de nitruro PECVD basado en silano	9	1.13	0	8
DAMIOX11	Depósito de óxido PECVD TEOS1:1	9	1.03	0	8
DAMIOX21	Deposición de óxido PECVD TEOS ratio 2:1	9	1.06	0	8
DAMIOXC1	Deposición de óxido con silano PECVD	9	1.05	0	8
DAMIPASX	Depósito PECVD de óxido TEOS y nitruro para pasivación	9	2.19	0	8
DBPSGAAA	DEPOSICION 1.3µM BPSG (CMOS25)	0	0	87.03	4
DBPTEOSA	DEPOSICION 1.3µM BPTEOS(CMOS25)	30	30	0	0
DBPTEOSX	Deposición de óxido dopado PECVD TEOS de grosores variables	9	1.06	0	8
DEC-ESP	Decapado especial de resina	1.5	0	0	0
DEC-MNC	Decapado de resina en Tepla MNC	0.24	0	0	0
DEC-NIT	ERROR/NO HA EXISTIDO ESTE CODI	0	0	0	0
DEC-RESI	Decapado de resina	0.75	0	0	0
DNIT-ING	Depósito no estàndar de nitruro de silicio LPCVD	37.29	0	0	0
DNITAAA	DEP. ESTANDAR DE 1800Å SI3N4	35.26	0	0	0
DNITAAAB	DEP. ESTANDAR DE 1175Å SI3N4	32.62	0	0	0
DNITXXX	DEP. SEMIESTANDARD DE SI3N4	35.26	0	0	0
DNTPLOXF	Depósito de nitruro de silicio PECVD en obleas contaminadas	10	0	20	8
DNTPLXXX	DEPOSICION DE NITRURO PECVD	0	0	25.52	18
DOXF-ING	Depósito PECVD de Ingeniería en obleas contaminadas	10	0	20	8
DOXNTAAA	DEPOSICION PASIVACION PECVD	0	0	30.57	18
DOXNTXXX	Depósito de pasivación de grosor variable	0	0	30.57	18
DOXPLOXF	Depósito de óxido de silicio PECVD en obleas contaminadas	10	0	20	8
DOXPLXXX	DEPOSICION DE OXIDO PECVD	0	0	15.22	18
DPASXOXF	Depósito de óxido y nitruro de Si PECVD en obleas contaminadas	10	0	20	8
DPLA-ING	Depósito no estàndar de capas dielèctriques en el T12 por PECVD	0	0	40	18
DPOL-ING	Depósito no estàndar de Polisilicio por LPCVD	35.53	0	0	0
DPOLAAA	DEPOSICION DE 4800Å DE POLY	25.74	0	0	0
DPOLAAB	DEPOSICION DE 3500Å DE POLY	24.76	0	0	0
DPOLSENA	DEP. 1µ POLY (580°C/350MTORR)	35.53	0	0	0
DPOLXXX	DEPOSICION SEMIESTAND. DE POLY	25.74	0	0	0
DPP1AAB	DOPAJE DE POLY CON POCL3	22.72	0	0	0
DPYR-ING	A REALIZAR POR EL INGENIERO	0	0	87.03	4
DPYR-PSG	DEPOSICION DE 1µ OXIDO DOPADO	0	0	46.11	4
DPYR-UND	DEPOSICION DE 1µ OXIDO NO DOP.	0	0	56.51	4
DPYR-XXX	DEPOSICION ESP. DE OXIDO PYROX	0	0	87.03	4
DSIPLOXF	Depósito de silicio amorfo PECVD en obleas contaminadas	10	20	0	0
ESPECIAL	Proceso o etapa no estàndar (por SB)	0	0	0	0

FEIN-ESP	Proceso o etapa no estandar fuera de la Sala Blanca	0	0	0	0
FESP-SIC	FOTOLITOGRAFIA DE OBLEAS DE SIC	58.82	4.14	0	0
FESPECIA	Fotolitografía especial sense seqüència d'aliniament predefinida	58.82	14.5	0	0
FIN-OBL	OBLEAS TERMINADAS	0	8	0	0
FINAL	FINAL DEL RUN EN SB	0	8	0	0
FOTO-ALH	Fotolitografía sobre capas de aluminio con resina estándar, para grabado húmedo	0	10.36	0	0
FOTO-ESP	Fotolitografía no estandar con proceso predefinido por usuario	58.82	14.5	0	0
FOTO-FCD	Fotolitografía estándar en obleas a doble cara sin protección de dorso	58.82	5.92	0	0
FOTO-FKD	Fotolitografía con alineamiento entre caras, SIN protección de cara opuesta	58.82	10.06	0	0
FOTO-FKR	Fotolitografía con alineamiento entre caras, con protección de cara opuesta	58.82	14.2	0	0
FOTO-FPU	ELIMINADA . Es substitueix per una FOTO * i una PROT	0	13.67	0	0
FOTO-FRD	Fotolitografía a 1 cara para obleas pulidas por ambas caras, con protección de c	58.82	10.06	0	0
FOTO-ING	Fotolitografía en condiciones no estándar acordadas con ingeniería	0	75.97	0	0
FOTO-MNC	Fotolitografía MNC, 1 ó 2 cares.Replicació dels procès CMOS.	58.82	14.5	0	0
FOTO-SAR	Fotolitografía sobre aluminio, con resina antireflectante. Apta para grabado sec	0	11.36	0	0
FOTO-SPA	FOTO STEPPER ANTI-REFLEC	7.02	10.67	0	0
FOTO-SPR	ELIMINADA Era per el Stepper Canon . Una máquina ja desballestada	7.02	9.78	0	0
FOTO-STA	Fotolitografía con stepper para grabado seco de Al	7.02	10.36	0	0
FOTO-STN	Fotolitografía estándar con stepper (Proyección)	7.02	11.36	0	0
FOTO-STU	Fotolitografía estándar, alineamiento a 1 cara	0	10.36	0	0
GCA-ING	FOTO EN MCM POR EL INGENIERO	4160	1781	0	0
GGIR-ESP	GRAVAT SEC NO ESTANDAR EN EL GIR 160.	32.4	0.28	0	0
GGIR-ING	GRABADO SECO INGENIERIA EN GIR 160	32.4	0.28	0	0
GHUM-ESP	Grabado húmedo especial	168.4	0	0	0
GHUM-ING	Grabado húmedo de ingeniería	168.4	0	0	0
HEX-ING	GRABADO RIE-MCM POR INGENIERO	454	0	0	0
ICAMPC25	I.I. DE CAMPO (CMOS-25)	16.49	0	0	0
IF&DNC25	I.I. REGIONES N++ (CMOS-25)	16.92	0	0	0
IF&DPC25	I.I. REGIONES P++	16.49	0	0	0
IGATEC25	I.I. AJUSTE VT (CMOS-25)	16.49	0	0	0
IMIMCING	Implantación en el IMC-210rd	25	0	0	0
IMP-HIGH	Implantacion ionica de alta dosis	27	0	0	0
IMP-LOW	Implantacion ionica de dosis baja	22	0	0	0
IMP-SUP	Implantacion ionica de muy alta dosis	37	0	0	0
IMPL-B	IMPLANTACION I. DE BORO	16.49	0	0	0
IMPL-BF2	IMPLANTACION IONICA DE BF2	15.29	0	0	0
IMPL-ESP	IMPLANTACION ESPECIAL	25	0	0	0
IMPL-ING	Implantación iónica de ingeniería	25	0	0	0
IMPL-P	IMPLANTACION I. DE FOSFORO	16.92	0	0	0
INICIO	PREPARAR EL INICIO DEL RUN	0	0	0	0
IPOUNC25	I.I. PARA POZO N (CMOS-25)	16.92	0	0	0
IPOUPC25	I.I. PARA POZO P (CMOS-25)	16.49	0	0	0
M3120ING	A REALIZAR POR EL INGENIERO	53539	0	0	0
M3180ING	Metalización de ingeniería en el sputtering Varian 3180	14.04	2.5	0	0
MA610-PT	DEPOSICION DE PT	0	56.34	14.04	8
MA610-XX	DEPOSICIONES DIVERSAS	0	22.99	14.04	8
MA610ING	A REALIZAR POR EL INGENIERO	0	56.34	14.04	8
MARC-EAL	OBL. EPI. CMOS25	0	65.7	0	0
MARC-EAO	OBL. EPI. CMOS175	0	68.75	0	0
MARC-ESP	OBLEAS ESPECIALES	0	0	0	0
MARC-EXT	OBLEAS EXTERIORES	0	0	0	0
MARC-GEN	OBLEAS VARIAS	0	0	0	0
MARC-NAA	OBLEAS N, 1-12 OHM.CM	0	24.75	0	0

MARC-PAA	OBLEAS P, 4-40 OHM.CM	0	24.75	0	0
MARC-PAC	OBLEAS P, 0.1-1.4 OHM.CM	0	24.75	0	0
MARC-POT	OBLEAS PROYECTOS DE POTENCIA	0	0	0	0
MARC-PXA	OBLEAS P,4-40OHM CM,300µ SEN..	0	61.81	0	0
MARC-PXB	OBL. P, 10-20OHM.CM 500µ 2 PUL	0	50	0	0
MARC-SEN	OBLEAS PROYECTOS DE SENSORES	0	0	0	0
MARC-SOI	OBLEAS TIPO SOI	0	0	0	0
MARC-TEC	OBLEAS TECNOLOGIA DE SILICIO	0	0	0	0
MARCAR	MARCAR OBLEAS	0	0	0	0
MARCPY05	OBLEAS PYREX 0,5 mm/con flat	0	35	0	0
MAU-UIING	Deposición por evaporación de capas o multicapas en las que se requiera Au.	14.04	0	56.34	4
MEALCU	DEPOSICION DE AL/CU	14.04	0.63	0	0
MEALSICU	DEPOSICION DE AL/SI/CU	14.04	0.63	0	0
MES-ESP	MEDIDAS ESPECIALES	0	0	0	0
MES-NANO	MEDIR EN EL NANOSPEC	0	0	0	0
MET-ESP	METAL.LITZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0
MET-VARI	DEPOSICIÓN DE AL + 1% SI	44946	0	0	0
MEV-UIING	Deposición por evaporación de cualquier capa o multicapa excepto de Au o de Pt.	14.04	11.91	0	0
MEVAC175	DEP. DE 1µM AL/SI/CU	14.04	0.63	0	0
MEVAC25	DEP. DE 1µM AL/CU	14.04	0.63	0	0
MEVADORS	METALIZACION DORSO AL/SI/CU	8.64	0.63	0	0
MEVPKING	Evaporación de Ti, Al o Cr.	14.04	11.91	0	0
MEVPUING	Deposición de materiales por evaporación.	14.04	11.91	0	0
MK500ING	metalización en sputtering KS500C	0	11.91	14.04	4
MK800ING	Metalizacion en sputtering KS800H	0	11.91	14.04	4
MPT-UIING	Deposición por evaporación de capas o multicapas en las que se requiera usar Pt.	14.04	0	56.34	4
MRC-ING	DEPOSITO MRC-MCM POR INGENIERO	0	0	65	6
MRCTNING	Deposito de Ti o Ni por ingeniero	0	0	25	6
MSKOHING	Micromecanizado del silicio en volumen en KOH en trozos o obleas especiales	0	0	92	2
MSKOHMNC	Micromecanizado del silicio en volumen mediante KOH en obleas contaminadas	0	0	92	2
MSKOHXXX	Micromecanizado del silicio en volumen en KOH para obleas limpias	0	0	57	2
MSLIFING	Estructuración de capas de metal sin grabado químico. Procesos especiales	0	18.16	0	4
MSLIFTOF	Estructuración de metal sin grabado químico	0	10.89	0	4
MST-ESP	Procesado no estándar de muestras en el laboratorio de microsistemas	0	10.06	0	0
MSTMHING	Micromecanizado del silicio en volumen enTMAH en trozos o obleas especiales	0	0	372	2
MSTMHMNC	Grabado anisótropo de silicio en TMAH para obleas contaminadas	0	0	372	2
MSTMHXXX	Micromecanizado del silicio en volumen mediante TMAH en obleas limpias	0	0	197	2
MZ550ING	Metalización de Al de ingeniería en el sputtering Leybold Z550	0	11.91	14.04	4
MZ550VID	METALIZACION DE VIDRIOS	8.64	11.91	0	0
NET1-SIC	Limpieza general para obleas de SiC	55.16	0	0	25
NET2-SIC	Limpieza general para obleas de SiC previa a una oxidación	77.3	0	0	25
NET3-SIC	Limpieza general para obleas de SiC previa a un recocido a alta temperatura	73.16	0	0	25
NET4-SIC	Limpieza general para obleas de SiC al inicio de run	79.04	0	0	25
NETE-SIC	LIMPIEZA ESPECIAL DE SIC Y/O GAN	208.96	0	0	0
NETG-DIS	Limpieza con disolventes (Acetona / IPA)	47.1	0	0	0
NETG-ESP	LIMPIEZA ESPECIAL	135.92	0	0	0
NETG-GEN	Limpieza general	135.92	0	0	0
NETG-HF	Limpieza general con HF	62.88	0	0	0
NETG-ING	Limpieza húmeda de ingeniería	135.92	0	0	0
NETG-MNC	Limpieza general en MNC	67.91	0	0	0
NETG-RCA	Limpieza RCA	77.35	0	12.55	25
NETG-SIC	LIMPIEZA GENERAL PARA OBLEAS DE SIC	208.96	0	0	0
NETG-SIM	Limpieza simple	92.33	0	0	0

NETGH2OC	LIMPIEZA CON AGUA OBLEAS-MET	19.29	0	0	0
NETGH2OS	LIMPIEZA CON AGUA SIN METAL	19.29	0	0	0
NETS-MNC	Limpieza simple en MNC	51.35	0	0	0
NH2O-MNC	Limpieza con agua en MNC	27.23	0	0	25
NIT-ING	A REALIZAR POR EL INGENIERO	6760	0	0	0
O&R-ESP	OXIDACION O RECOCIDO ESPECIAL	127.82	0	0	0
O&R-ING	Proceso de oxidación o recocido de ingeniería	127.82	0	0	0
OBLEAS	INCORPORAR OBLEAS DEL RESPONS.	0	0	0	0
ODPP0AAA	DOPADO POC13 DEL POLY 0 CMOS25	22.72	0	0	0
OFLDFAAD	FLUID.OXIDO INTERNIVEL CMOS25	42.65	0	0	0
OHC-0780	OXIDACION DE PUERTA DE 780A	59.37	0	0	0
OHC-1000	OXID.DE 1000Å A 950°C	34.8	0	0	0
OHC-1M	OXIDACION DE 1 µM A 1100°C	67.56	0	0	0
OHC-1M5	OXIDACION DE 1.5 MICRAS	104.95	0	0	0
OHC-4000	OXIDO HUMEDO DE 4000Å A 1100C°	41.59	0	0	0
OHC-8000	OXIDACION HUMEDA DE 8000Å	56.55	0	0	0
OHC-XXX	OXIDO VARIABLE A 1100°C	67.56	0	0	0
OPOC4800	DOPAJE POCL3 DE 4800Å DE POLY	22.39	0	0	0
OPOC6000	DOPADO POC13 DE 6000Å DE POLY	24.02	0	0	0
OPOCSENA	DOPADO POC13 DEL SILICIO	35.2	0	0	0
ORCALAAA	RECOCIDO ALUMINIO CMOS25	10.5	0	0	0
ORECNEUT	RECOCIDO A DIF. TEMPERATURAS	64.81	0	0	0
ORECOXID	RECOCIDO A DIF. TEMPERATURAS	105.47	0	0	0
OREPOAAA	RECOCIDO DE POZO CMOS25	95.49	0	0	0
OSC-0300	OXID.SECA DE 300Å A 1000°C	38.91	0	0	0
OSC-0500	OXID. SECA DE 500Å A 1000°C	83.53	0	0	0
OX800AAA	OXID. SECA A 800°C	38.91	0	0	0
OX800DLA	OXID. DILUIDA A 800°C	38.91	0	0	0
OXCMAAA	OXIDACION DE CAMPO (CMOS25)	127.82	0	0	0
OXCMAAB	OXIDACION DE CAMPO 7500Å	84.1	0	0	0
OXI-QUAD	GRABADO SECO DEL OXIDO DE SILICIO SIN PRESENCIA DE ALUMINIO	1.3	0.4	0	0
OXINAAA	OXIDO INICIAL CMOS25	48.59	0	0	0
OXNT-RIE	ATAC PER RIE DE LA PASSIVACIO	1.79	0.9	0	0
OXPDAAA	OXIDO DE PEDESTAL CMOS25	61.41	0	0	0
OXPOAAA	OXIDACION DEF. POZO N (CMOS25)	38.69	0	0	0
OXPTAAA	OXIDO DE PUERTA CMOS25	104.04	0	0	0
OXPTAAB	OXIDACION DE PUERTA.250Å	72.8	0	0	0
XPVAAA	OXIDO SACRIFICIAL 920Å CMOS25	132.65	0	0	0
P601-ESP	Grabado de diferentes materiales en el DRIE ALCATEL 601E	5	40.11	0	0
P601-ING	Grabado de diferentes materiales a múltiples profundidades en Alcatel 601-E.	10	20	0	0
P601CONT	Grabado profundo de contactos en el Alcatel 601-E	10	20	0	0
P601DEEP	Grabado profundo de silicio en el alcatel 601-E	10	20	0	0
P601POLI	Grabado de polisilicio en el Alcatel 601-E	10	20	0	0
PAMI-ESP	Grabado de diferentes materiales en el AMI ETCH P-5000	32.4	0.33	0	0
PAMS-ESP	Grabado de diferentes materiales en el ALCATEL AMS-110 DE en obleas MNC	5	25.91	0	0
PAMS-ING	Grabado seco de diferentes capas para obleas MNC	10	20	0	0
PAMS-OX	Grabado de dieléctricos para obleas MNC	11.29	0.77	0	4
PAMSDEEP	Grabado profundo de Silicio en obleas MNC en Alcatel AMS 110	5	25.91	0	4
PFAB-ING	PLASMA O2 MCM POR INGENIERO	1.28	0	0	0
PGIDPC25	DECAPADO EN SECO DE POLISILICIO CARA POSTERIOR CMOS25 EN GIR 160	0	0.9	0	0
PGIDPXXX	DECAPADO EN SECO DE POLISILICIO DE LA CARA POSTERIOR EN GIR 160	0	0.9	0	0
PGINISEN	GRABADO SECO DE NITRURO DE SILICIO PARA SENSORES EN GIR 160	0	0.94	0	0
PGINIXXX	GRABADO SECO DE NITRURO DE SILICIO EN GIR 160	0	0.94	0	0

PGIOPC25	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE PASIVACION EN GIR 160	0	0.66	0	0
PGIOXGUI	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE SILICIO PARA GUIAS EN GIR 160	0	1.21	0	0
PGIOXXX	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE SILICIO EN GIR 160	0	0.66	0	0
PGIPOXXX	GRABADO EN SECO DE POLISILICIO EN GIR 160	0	0.51	0	0
PGISPC25	GRABADO EN SECO DE OXIDO DE SILICIO PARA "SPACER" EN GIR 160	0	0.74	0	0
PGVIC25	GRABADO SECO DE OXIDO DE SILICIO DE LAS VIAS EN GIR 160	0	0.74	0	0
POXF-1AL	Grabado seco de Al entre 0,5 - 1,5 um en Oxford Plasmalab System 100	97.17	0.57	0	4
POXF-2AL	Grabado seco de Al entre 1,5 - 3 um de Al en Oxford Plasmalab System 100	97.17	1.14	0	4
POXF-ESP	Grabado seco no standard en Oxford Plasmalab System 100	97.17	0.57	0	4
POXF-ING	Grabado de ingeniería de Aluminio en el Oxford Plasmalab System 100	97.17	1.14	0	4
PQ1NIC25	GRABADO NITRURO CMOS25	1.3	0.25	0	0
PQ1NIXXX	GRABADO NITRURO EN EL QUAD	1.3	0.25	0	0
PQ1P0C25	GRABADO DE POLI-0 DEL CMOS-25	1.3	0.42	0	0
PQ1P1C25	GRABADO DE POLI-1 DEL CMOS 25	1.3	0.53	0	0
PQ2AL3µM	GRABADO DE 3 µM AL EN EL QUAD	20.59	4	0	0
PQ2ALC25	GRABADO DE AL DEL CMOS 25	20.59	1.38	0	0
PQ2ALXXX	GRABADO DE AL EN EL QUAD	20.59	1.38	0	0
PRE-GRAV	BARREL RES.DE MEJORA DE GRAV.	0.49	0	0	0
PROC-URG	PROCEDIMIENTO DE URGENCIA	0	0	0	0
PROT-BII	Net, 162cares. D.U.V+ Bake fins 180°C de resina 6512. Foto previa	0	0	0	0
PROT-GEN	Net,1o2cares. Depositar resina 6512 sobre cara pulida+Bake 125°C	0	4.14	0	0
PROT-GHU	Net, 162 cares. Només Bake 125°C Resina 6512. Foto previa	0	0	0	0
PROT-PDU	Net, 1cara Depositar 6512 sobre cara rugosa+Bake 115°C	0	4.14	0	0
PROT-SIC	DEPOSITO DE RESINA PARA PROTECCION EN SIC	0	4.14	0	0
QDAL-SIC	DECAPADO DE ALUMINIO EN MUESTRAS SIC	101.43	0	0	0
QDNITC25	Decapado de nitruro CMOS 25	117.62	0	0	0
QDNITXXX	Decapado de nitruro	117.62	0	0	0
QDOX1C25	Decapado del 1er óxido de CMOS-25	57.02	0	0	0
QDOX2C25	Decapado del 2º óxido del CMOS-25	57.02	0	0	0
QDOXDXXX	Decapado de óxido dopado	94.54	0	0	0
QDOXNC25	Decapado del oxi-nitruro	57.02	0	0	0
QDOXTXXX	Decapado de óxido térmico sin Al	57.02	0	0	0
QDPSGC25	DECAPADO DEL PSG DEL CMOS-25	55.56	0	0	0
QDRACXXX	Decapado de resina en ácido	92.33	0	0	0
QDRDIXXX	Decapado de resina en disolvente	128.5	0	0	0
QGACSXXX	Grabado de Al/0.5% Cu/0.75% Si	168.4	0	0	0
QGAL-SIC	GRABADO DE ALUMINIO CON MASCARA DE RESINA EN SIC	101.43	0	0	0
QGALCXXX	Grabado de Al/0.5% Cu	101.43	0	0	0
QGALSXXX	Grabado de AL/1% Si	168.4	0	0	0
QGOX-SIC	Grabado de óxido con máscara de resina sobre SiC	57.02	0	0	0
QGOX-XXX	Grabado de óxido sin máscara	57.02	0	0	0
QGOX0300	Grabado de óxido de 300 Å	57.02	0	0	0
QGOX1C25	Grabado de óxido sacrificial	57.02	0	0	0
QGOX2500	Grabado de óxido de 2500 Å	57.02	0	0	0
QGOX8000	Grabado de óxido de 8.000Å	57.02	0	0	0
QGOXDXXX	Grabado de óxido dopado	94.54	0	0	0
QGOXNXXX	Grabado de óxido con máscara de nitruro	57.02	0	0	0
QGOXRXXX	Grabado de óxido con máscara de resina	57.02	0	0	0
QPRMEC25	Paso previo a la metalización	82.51	0	0	0
QREDUC25	Limpieza pre-deposición de poli	82.51	0	0	0
QSCALMNC	Grabado húmedo de Al en MNC	77.23	0	0	0
QSCAUMNC	Grabado húmedo de Au	120	0	0	0
QSCDRMNC	Decapado de resina en húmedo con MNC	187.85	0	0	0

QSCNGMNC	LIMPIEZA CON AGUA CON M.N.C.	18.67	0	0	0
QSCNIMNC	Grabado húmedo de Ni en MNC	77.23	0	0	0
QSCOXMNC	Grabado de óxido en MNC	77.23	0	0	0
QSCPMNC	Paso previo a la metalización MNC	74.42	0	0	0
QSCTCMNC	Grabado tricapa TI/NI/AU MCM	120	0	0	0
QSCTIMNC	Grabado húmedo de Ti con MNC	77.23	0	0	0
QUAD-ESP	GRAVAT SEC ESPECIAL. QUAD.	5	3	0	0
QUAD-ING	GRAB. SECO DE ING. EN QUAD	5	3	0	0
REC-ALU	RECOCIDO ALUMINIO A 450°C	8.31	0	0	0
REIMAAB	RECOCIDO POST IMPLANTACION	25.58	0	0	0
REPOAAA	RECOCIDO DE POZO	5539	0	0	0
REPOAAB	RECOCIDO DE POZO A 1150°C	132.37	0	0	0
RTPD-ING	Proces de recuita rapida o RTCVD a l'equip AS-Master 2000	10.51	0	0	1
SCP-ING	GRAB. HUMEDO DE ING. EN MCM	120	0	0	0
SFI-ING	DEPOSITO SFI-MCM POR INGENIERO	0	12.69	0	0
TAP-QUAD	GRAVAT D'OXID "TAPERETCH"	1.3	0.41	0	0

ETAPA	CONCEPTO	Precio Unitario	Unidades
SERV-SE	Corte de silicio	15.91	Oblea
	Corte oblea vidrio	29.22	Oblea
	Soldadura de hilos	0.43	Hilo
	Bases DIL16	20	Unidad
	Bases DIL 24	44	Unidad
	Baes DIL 48	63.5	Unidad
	Bases TO-8	8.64	Unidad
	Chip bonding	0.51	Chip
	Bonding PCB	1.21	Unidad